



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Λία Παπαδοπούλου  
ΑΡΙΘΜ. ΤΗΛΕΦ.: 2810 391303  
E-MAIL: liap@iesl.forth.gr

Ηράκλειο, 31/7/2017  
Αριθ. Πρωτ. Προκήρυξης: 616

## ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) / Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λείζερ (ΙΗΔΛ)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των νόμων 4310/2014 (ΦΕΚ 258 Α'/8-12-2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις και 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την Έρευνα και άλλες διατάξεις»,
2. Τον Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό» για τον έλεγχο των δαπανών βάσει του Προϋπολογισμού του ΙΤΕ.
3. Το Π.Δ. 432/1987 ΦΕΚ 204/Α/87 «Σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία, «Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
4. Τις διατάξεις του ΠΔ 113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες.
5. Τις διατάξεις της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280/Α/2006) «Αναστολή Διορισμών και Προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
6. Τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού του ΙΤΕ (ΦΕΚ Β' 1584/31.7.2009) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Β' 2193/31.12.2010)
7. Την απόφαση του ΔΣ/ΙΤΕ 358/23-6/22.7.17 με την οποία εγκρίθηκε η προκήρυξη θέσης Ερευνητού Β' ή Γ' Βαθμίδας.

## ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ:

Μία (1) θέση Ερευνητού Β' ή Γ' βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο:  
« **Νανοϋλικά για εφαρμογές στην ενέργεια ή/και στο περιβάλλον**»

## ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση πρέπει:

- α) Να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος
- β) Να έχουν τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 18 του Ν. 4310/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, για την Β' και Γ' Βαθμίδα ερευνητών, ήτοι: να είναι επιστήμονες υψηλής επιστημονικής εμπειρίας και κατάρτισης, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, που εργάζονται αυτοτελώς και ανεξάρτητα για την παραγωγή ή βελτίωση γνώσεων και την εφαρμογή τους, για την παραγωγή προϊόντων, διατάξεων, διαδικασιών, μεθόδων και συστημάτων.

Ειδικότερα, οι υποψήφιοι, για την **Β΄ Βαθμίδα** θα πρέπει να έχουν τεκμηριωμένη ικανότητα να διευθύνουν προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να συντονίζουν και να κατευθύνουν την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη στα επί μέρους έργα του προγράμματος έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να αναζητούν και να προσελκύουν οικονομικούς πόρους από εξωτερικές πηγές για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του ινστιτούτου ή του κέντρου και να προωθούν πρωτοποριακές ιδέες στην επιστήμη και την τεχνολογία. Να έχουν πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά και τεχνικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους ή να έχουν διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας και να έχουν προσφέρει στην πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας και των εφαρμογών τους και η συμβολή τους στην πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας να έχει τύχει αναγνώρισης από άλλους ερευνητές.

Οι υποψήφιοι για την **Γ΄ Βαθμίδα** θα πρέπει να έχουν τεκμηριωμένη ικανότητα να σχεδιάζουν και να εκτελούν έργα ή τμήματα έργων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να κατανέμουν τμήματα ή φάσεις του έργου σε άλλους ερευνητές και να τους καθοδηγούν ή επιβλέπουν. Να έχουν πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένα. Οι υποψήφιοι για την Βαθμίδα Γ΄ θα πρέπει να έχουν εμπειρία τριών ετών στην εκτέλεση ερευνητικού έργου.

- γ) Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
Για τους πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται η άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται με τίτλο σπουδών Ελληνικού εκπαιδευτικού ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή απολυτήριο τίτλο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, ή με αντίστοιχο Πιστοποιητικό του Σχολείου της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση των υποψηφίων.
- δ) Να μην υπάρχει στο πρόσωπό τους κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη
- ε) Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

**Οι υποψήφιοι θα πρέπει απαραίτητα να υποβάλουν:**

1. Αίτηση υποψηφιότητας (χειρόγραφη ή δακτυλογραφημένη), στην οποία ο/η ενδιαφερόμενος/η θα ζητεί να γίνει δεκτή η υποψηφιότητά του/της και θα αναφέρει τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά.
2. Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα και ανάπτυπα εργασιών, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε 5 αντίγραφα (στα ελληνικά και αγγλικά)
3. Αναλυτικό υπόμνημα για το επιστημονικό και ερευνητικό τους έργο σε 5 αντίγραφα (στα αγγλικά).
4. Αντίγραφα τίτλων σπουδών με τα οποία θα αποδεικνύονται τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα:
  - α. Απλά και ευανάγνωστα αντίγραφα εάν πρόκειται για έκδοση από δημόσιο φορέα ή
  - β. Απλά και ευανάγνωστα αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπíπτουν στη ρύθμιση Ν. 4250/2014 ή
  - γ. Ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο. Εφ΄ όσον πρόκειται για τίτλους σπουδών

από πανεπιστήμια του εξωτερικού, για τους Έλληνες πολίτες, απαιτείται και πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) ή τουλάχιστον κατατεθειμένη αίτηση.

5. Υπεύθυνη Δήλωση του 1599/86 που να δηλώνεται από τους υποψηφίους ότι πληρούν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα της παρούσας Προκήρυξης.

#### **Κατάθεση Δικαιολογητικών:**

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν σχετική αίτηση υποψηφιότητας, συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (να εσωκλείεται και αρχείο σε ηλεκτρονική μορφή):

- αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή
- ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφορών *(σφραγίδα ταχυδρομείου ή αποδεικτικό αποστολής εταιρείας ταχυμεταφορών έως την καταληκτική ημερομηνία)* στην παρακάτω διεύθυνση:

ΙΗΔΛ/ΙΤΕ

Υπόψη: κ. Λία Παπαδοπούλου

Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών

700 13 Ηράκλειο, ΚΡΗΤΗ

Τηλ. 2810 391300 ή 391303

- με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση: [liap@iesl.forth.gr](mailto:liap@iesl.forth.gr)

#### **Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: 30/9/2017.**

Η παρούσα Προκήρυξη θα δημοσιευθεί όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις (άρθρο 29 παρ. 2 Ν. 4310/2014 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Ο Διευθυντής του ΙΗΔΛ/ΙΤΕ

Σ.Χ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

P.N. 616

Heraklion, 31/7/2017

**FOUNDATION FOR RESEARCH AND TECHNOLOGY-HELLAS  
INSTITUTE OF ELECTRONIC STRUCTURE AND LASER**

**ANNOUNCEMENT**

According to Greek legislation, the Foundation for Research and Technology-Hellas/Institute of Electronic Structure and Laser (established by the Presidential Decree 432/1987), based on the decision of its Board of Directors of July 2017 (358/23-6/22.7.17) announces the opening of one (1) position at the Researcher B' or C' level, as follows:

- One (1) position at the Researcher B' or C' level in the following research field:

***“Nanomaterials for applications in energy and the environment”***

Requirements: - Ph.D degree  
- Published work in scientific journals  
- Excellent knowledge of the greek language

Information regarding more specific requirements and submission of relevant documents is available only in greek.

**Contact person for information:**

Mrs. Lia Papadopoulou  
FORTH/IESL  
100, N. Plastira str.  
700 13 Heraklion, Crete  
Greece  
Tel: +30 2810 391303  
e-mail: liap@iesl.forth.gr

Deadline for applications: **30/9/2017**

The Director of IESL/FORTH

S.H. ANASTASIADIS